



中国科学院科学出版基金资助出版

半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 17 卷 第 9 期 1996 年 9 月

目 次

- MOCVD 和 GSMBE 生长 $Ga_{0.5}In_{0.5}P$ 外延层中有序结构的研究 董建荣 李晓兵 孙殿照 陆大成 李建平 孔梅影 王占国 (641)
- 宽禁带 II-VI 族四元合金 $Zn_{1-x}Mg_xS_ySe_{1-y}$ 成分的定量俄歇分析 斯彩霞 凌震 谢长生 俞根才 王杰 赵国珍 (646)
- 1.48 μm 掺铒光纤放大器泵源 彭怀德 刘德钧 阎莉 王丽明 张洪琴 王仲明 夏彩虹 孙国喜 (651)
- 测定半导体激光器源分布的一种有效方法 曾小东 梁昌洪 (655)
- 扫描电子声显微镜在半导体材料分析中的应用 张冰阳 江福明 惠森兴 杨阳 姚烈 殷庆瑞 (659)
- 用全扩散法制作 MCT 张发生 周如培 周宝霞 陈治明 (664)
- 新型结构的 1.3 μm Ge_xSi_{1-x}/Si MQW 波导探测器的优化设计 刘育梁 杨沁清 王启明 (667)
- 小面积 PN 结的光电特性 尹长松 黄黎蓉 (674)
- 集成电路功能成品率模拟与设计方法 郝跃 朱春翔 张卫东 (677)
- 改进的电迁移独立失效元模型 李志宏 顾页 武国英 王阳元 (683)
- 短沟道 CMOS/SOI 器件加固技术研究 张兴 吴雪梅 王阳元 (689)
- 注氟 SIMOX 隐埋 SiO_2 的辐照感生电荷分布特性 竺士炀 林成鲁 高剑侠 李金华 (693)
- 大剂量氧注入硅中的再分布理论及其快速计算 吴雪梅 赵清太 张兴 李映雪 王阳元 陈新 王佑祥 (698)
- MeV Si 离子注入对 BF_2 注入 Si 样品特性的影响 赵清太 王忠烈 (706)
- a-SiN : H 的退火处理及其对 a-Si : H TFT 性能与可靠性的影响 李秀京 陈治明 田敬民 (713)
- 研究快报**
- As^+ 注入 $Si_{1-x}Ge_x$ 的快速退火行为 邹吕凡 王占国 孙殿照 何沙 范缇文 刘学锋 张靖巍 (717)